

2018 年日本表面真空学会中部支部研究会  
『Si 表面・界面・ナノ構造の研究最前線』

シリコンは、確立された微細加工技術により精度よくナノ構造を作製できるため、今もなおナノ構造を利用したデバイス開発はもちろん、極小スケールで発現する物理現象の理解や新しい測定技術の確立に欠かせない材料である。このような観点から、今年の中部支部研究会では改めてシリコンを取り上げて、デバイス、物性、測定技術の側面から、最新の研究成果について4名の先生にご講演いただく。

日時：2018年11月30日（金） 13:00～16:50

場所：静岡大学創造科学技術大学院 2階会議室（浜松市中区城北3-5-1）

プログラム：

13:00 - 13:05 開会あいさつ  
市村 正也（名古屋工業大学，日本表面真空学会中部支部副支部長）

13:05 - 13:55 「Si-Ge ナノ構造制御で展開する電子デバイス開発」  
牧原 克典 先生，宮崎 誠一 先生（名古屋大学）

13:55 - 14:45 「Mechanism of thermal oxidation on Si surface and Si/SiO<sub>2</sub> interface」  
唐 佳藝 先生（兵庫県立大学）

14:45 - 15:05 休憩

15:05 - 15:55 「Si 表面・界面エンジニアリングによるフォノンおよび熱輸送制御とその応用」  
野村 政宏 先生（東京大学）

15:55 - 16:45 「チャージポンピング EDMR 法を用いた SiO<sub>2</sub>/Si 界面の欠陥検出」  
堀 匡寛 先生，小野 行徳 先生（静岡大学）

16:45 - 16:50 閉会あいさつ  
村上 健司（静岡大学，日本表面真空学会中部支部・現地世話人）

17:00 - 懇親会（静大生協・北館食堂：会費 4,000 円）

参加費：無料

申込方法：件名を「中部支部研究会参加申込」として，本文に

氏名（フリガナ），所属（企業名大学名），懇親会（参加・不参加）

を記載の上，

鈴鹿高専 平井信充（hirai@chem.suzuka-ct.ac.jp）

宛にメールにてお申し込みください

申込締切：2018年11月22日（木）\*余席があれば当日参加も受け付けます

問合せ先：静岡大学総合科学技術大学院 村上健司

TEL&FAX: 053-478-1329

e-mail: murakami.kenji@shizuoka.ac.jp